

- ◆ N-Channel Enhancement Mode
- ◆ Low Q_g and R_g
- ◆ High dv/dt
- ◆ Nanosecond Switching
- ◆ 30MHz Maximum Frequency

$$V_{DSS} = 1000 \text{ V}$$

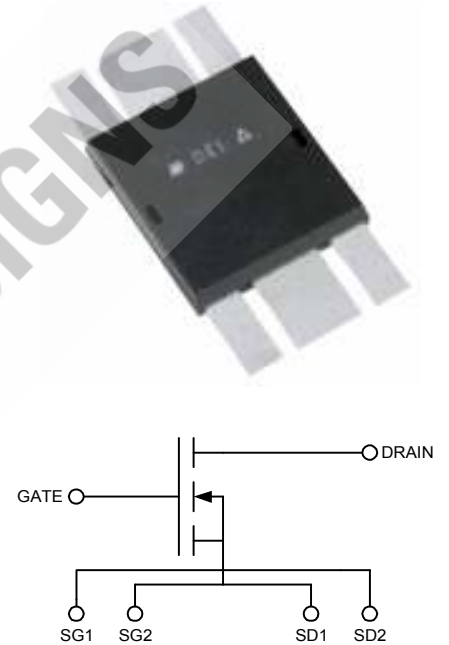
$$I_{D25} = 24 \text{ A}$$

$$R_{DS(on)} \leq 0.45 \Omega$$

$$P_{DC} = 1800 \text{ W}$$

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	1000	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}; R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	1000	V
V_{GS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_c = 25^\circ\text{C}$	24	A
I_{DM}	$T_c = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	144	A
I_{AR}	$T_c = 25^\circ\text{C}$	21	A
E_{AR}	$T_c = 25^\circ\text{C}$	30	mJ
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 0.2 \Omega$	5	V/ns
	$I_S = 0$	>200	V/ns
P_{DC}		1800	W
P_{DHS}	$T_c = 25^\circ\text{C}$ Derate $4.0 \text{ W}/^\circ\text{C}$ above 25°C	730	W
P_{DAMB}	$T_c = 25^\circ\text{C}$	4.5	W
R_{thJC}		0.08	C/W
R_{thJHS}		0.20	C/W

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		$T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified		
		min.	typ.	max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = 3 \text{ mA}$	1000		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 4 \text{ mA}$	3.5	4.4	5.5 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}_{DC}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 100 \text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = 0.8 V_{DSS}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$			50 μA
	$V_{GS} = 0$, $T_J = 125^\circ\text{C}$			1 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 15 \text{ V}$, $I_D = 0.5 I_{D25}$ Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$			0.45 Ω
g_{fs}	$V_{DS} = 15 \text{ V}$, $I_D = 0.5 I_{D25}$, pulse test		12	S
T_J		-55		+175 $^\circ\text{C}$
T_{JM}			175	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55		+175 $^\circ\text{C}$
T_L	1.6mm (0.063 in) from case for 10 s		300	$^\circ\text{C}$
Weight			3	g


Features

- Isolated Substrate
 - high isolation voltage (>2500V)
 - excellent thermal transfer
 - Increased temperature and power cycling capability
- IXYS advanced low Q_g process
- Low gate charge and capacitances
 - easier to drive
 - faster switching
- Low $R_{DS(on)}$
- Very low insertion inductance (<2nH)
- No beryllium oxide (BeO) or other hazardous materials

Advantages

- Optimized for RF and high speed switching at frequencies to 30MHz
- Easy to mount—no insulators needed
- High power density



DE475-102N21A RF Power MOSFET

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		(T _J = 25°C unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
R _G			0.3	Ω
C _{iss}			5500	pF
C _{oss}	V _{GS} = 0 V, V _{DS} = 0.8 V _{DSS(max)} , f = 1 MHz		190	pF
C _{rss}			52	pF
C _{stray}	Back Metal to any Pin		46	pF
T _{d(on)}			5	ns
T _{on}	V _{GS} = 15 V, V _{DS} = 0.8 V _{DSS} I _D = 0.5 I _{DM}		5	ns
T _{d(off)}	R _G = 0.2 Ω (External)		5	ns
T _{off}			8	ns
Q _{g(on)}			155	nC
Q _{gs}	V _{GS} = 10 V, V _{DS} = 0.5 V _{DSS} I _D = 0.5 I _{D25}		33	nC
Q _{gd}			84	nC

Source-Drain Diode		Characteristic Values		
		(T _J = 25°C unless otherwise specified)		
Symbol	Test Conditions	min.	typ.	max.
I _S	V _{GS} = 0 V			21 A
I _{SM}	Repetitive; pulse width limited by T _{JM}			144 A
V _{SD}	I _F = I _S , V _{GS} = 0 V, Pulse test, t ≤ 300 μs, duty cycle ≤ 2%			1.5 V
T _{rr}			200	ns
Q _{RM}	I _F = I _S , -di/dt = 100A/μs, V _R = 100V		0.6	μC
I _{RM}			8	A

CAUTION: Operation at or above the Maximum Ratings values may impact device reliability or cause permanent damage to the device.

Information in this document is believed to be accurate and reliable. IXYSRF reserves the right to make changes to information published in this document at any time and without notice.

For detailed device mounting and installation instructions, see the "Device Installation & Mounting Instructions" technical note on the IXYSRF web site at;

http://www.ixysrf.com/pdf/switch_mode/appnotes/7de_series_mosfet_installation_instructions.pdf

IXYS RF reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

IXYS RF MOSFETS are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,860,072	4,881,106	4,891,686	4,931,844	5,017,508
5,034,796	5,049,961	5,063,307	5,187,117	5,237,481	5,486,715
5,381,025	5,640,045				

Fig. 1 **Typical Transfer Characteristics**
 $V_{DS} = 50V, I_D = 12A$

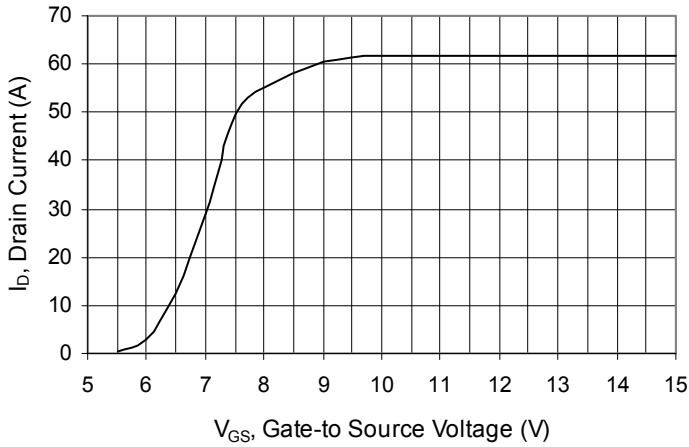


Fig. 2 **Typical Output Characteristics**
 $PW = 15 \mu S$

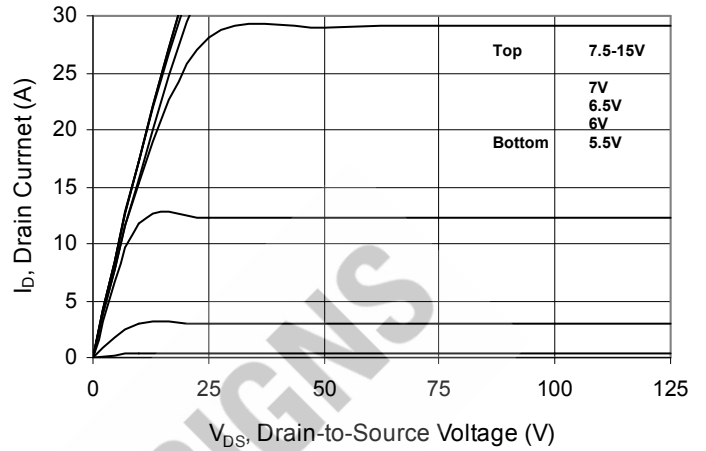


Fig. 3 **Gate Charge vs. Gate-to-Source Voltage**
 $V_{DS} = 500V, I_D = 12A$

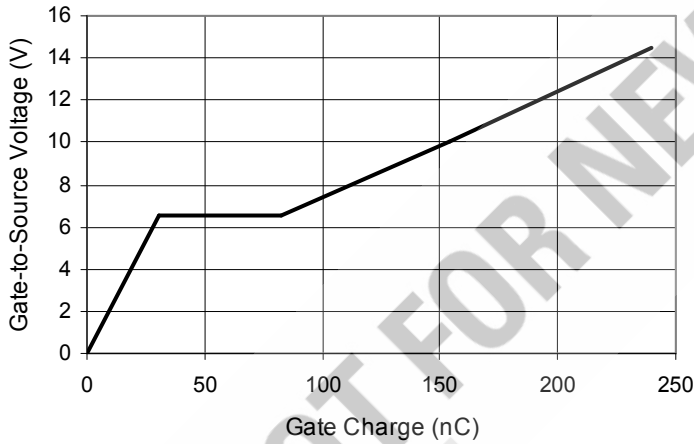


Fig. 4 **Extended Typical Output Characteristics**
 $PW = 15 \mu S$

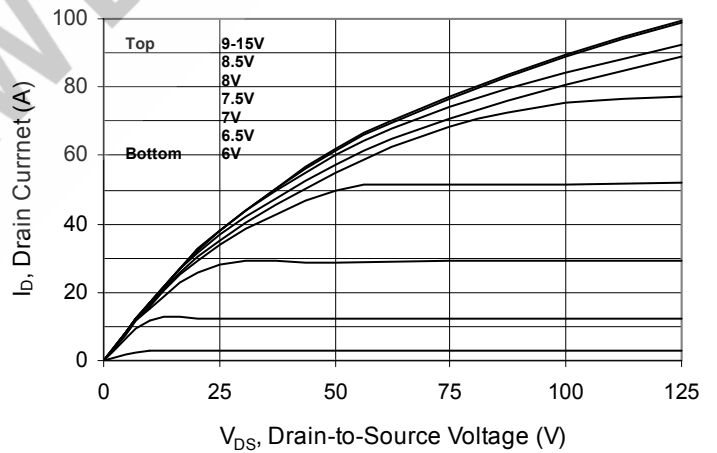


Fig. 5 **V_{DS} vs. Capacitance**

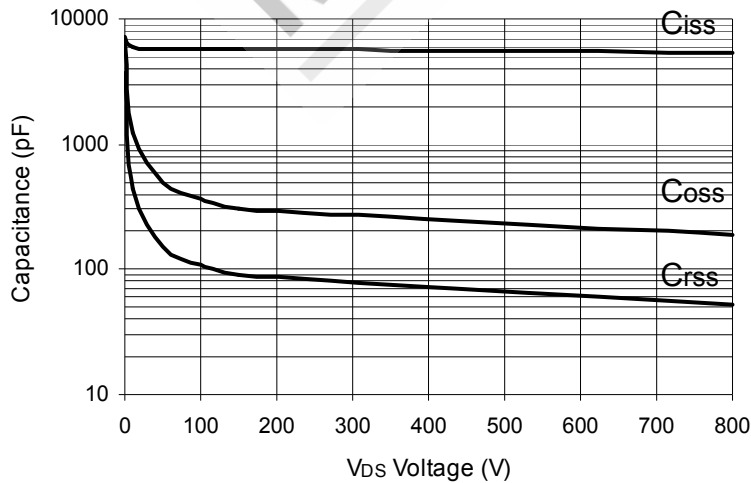
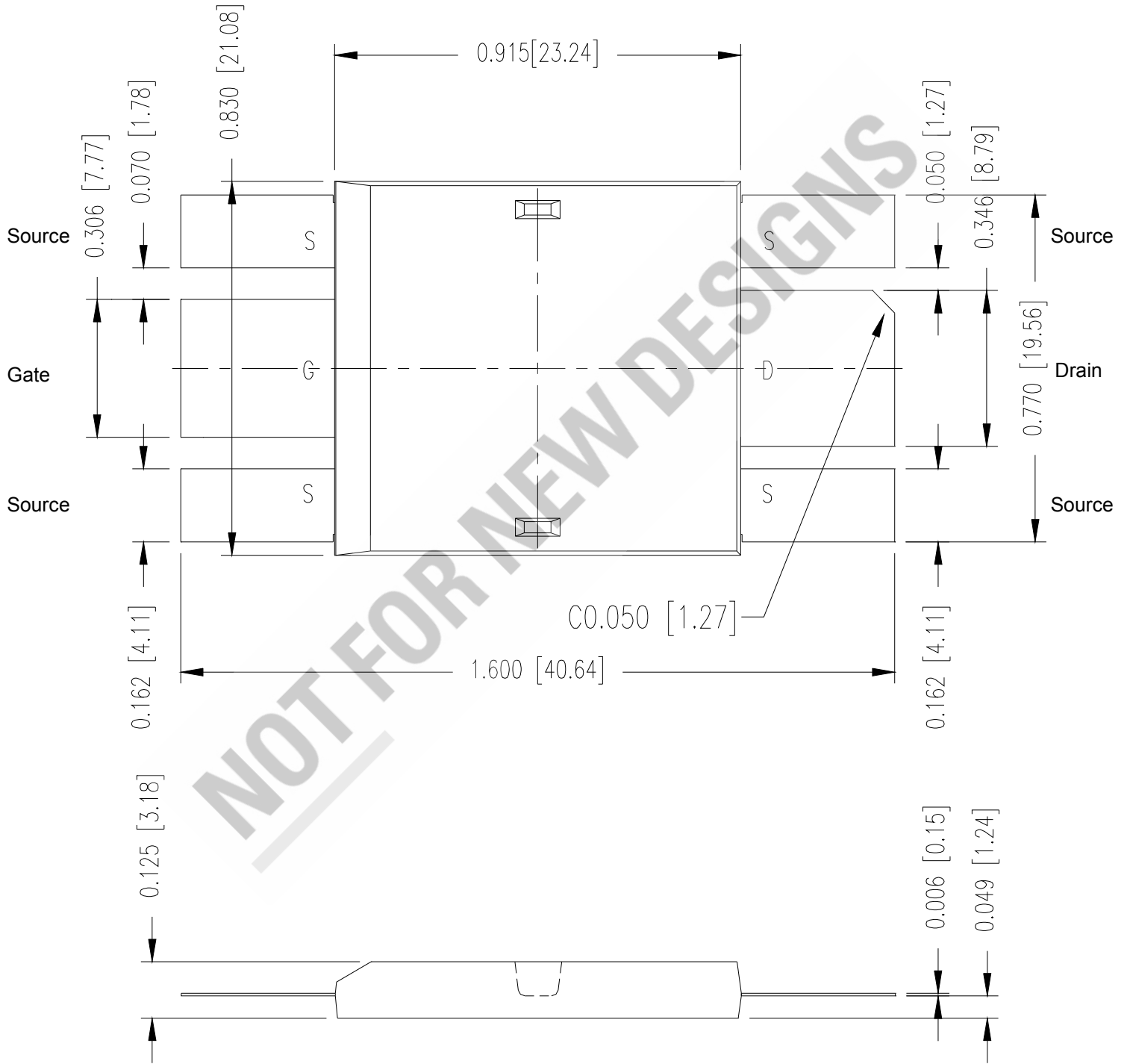


Fig. 6 Package Drawing



102N21A DE-SERIES SPICE Model (Preliminary)

The DE-SERIES SPICE Model is illustrated in Figure 7. The model is an expansion of the SPICE level 3 MOSFET model. It includes the stray inductive terms L_G , L_S and L_D . R_d is the $R_{DS(ON)}$ of the device, R_{ds} is the resistive leakage term. The output capacitance, C_{OSS} , and reverse transfer capacitance, C_{RSS} are modeled with reversed biased diodes. This provides a varactor type response necessary for a high power device model. The turn on delay and the turn off delay are adjusted via R_{on} and R_{off} .

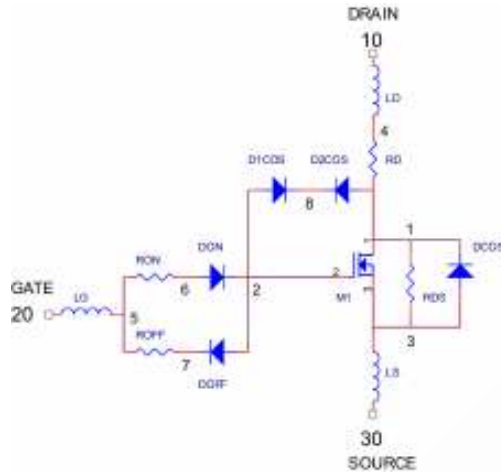


Figure 7 DE-SERIES SPICE Model

This SPICE model may be downloaded as a text file from the IXYSRF web site at

http://www.ixysrf.com/products/switch_mode.html

<http://www.ixysrf.com/spice/de475-102n21a.html>

Net List:

.SUBCKT 102N21A 10 20 30

* TERMINALS: D G S

* 1000 Volt 21 Amp 0.45 ohm N-Channel Power MOSFET

* REV.A 01-09-02

M1 1 2 3 3 DMOS L=1U W=1U

RON 5 6 0.3

DON 6 2 D1

ROF 5 7 .1

DOF 2 7 D1

D1CRS 2 8 D2

D2CRS 1 8 D2

CGS 2 3 5.5N

RD 4 1 0.45

DCOS 3 1 D3

RDS 1 3 5.0MEG

LS 3 30 .5N

LD 10 4 1N

LG 20 5 1N

.MODEL DMOS NMOS (LEVEL=3 VTO=3.0 KP=3.8)

.MODEL D1 D (IS=.5F CJO=1P BV=100 M=.5 VJ=.6 TT=1N)

.MODEL D2 D (IS=.5F CJO=400P BV=1000 M=.4 VJ=.6 TT=400N RS=10M)

.MODEL D3 D (IS=.5F CJO=900P BV=1000 M=.3 VJ=.4 TT=400N RS=10M)

.ENDS

Doc #9200-0247 Rev 6
© 2009 IXYS RF

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А